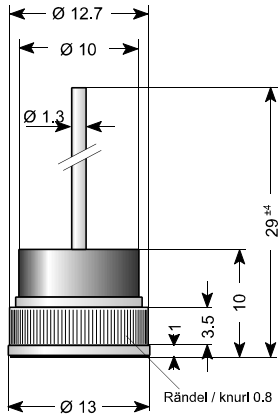


Silicon Protectifiers
with TVS characteristics
High-temperature diodes

Silizium Schutzgleichrichter
mit Begrenzereigenschaften
Hochtemperaturdioden



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	35 A
Breakdown voltage Abbruch-Spannung	20...40 V
Metal press-fit case with plastic cover Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung	
Weight approx. – Gewicht ca.	10 g
Casting compound has UL classification 94V-0 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert	

Standard packaging: bulk – Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

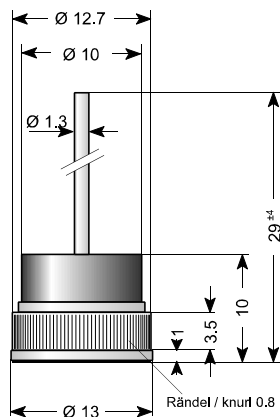
Grenzwerte

Type / Typ	Breakdown voltage	Reverse volt.	Forward voltage	Max. clamping voltage
Wire to / Draht an	Abbruch-Spannung	Sperrspannung	Durchlaßspanng.	Max. Begrenzerspanng.
Anode	Cathode	$I_T = 100 \text{ mA}$	$t_p = 0.3 \text{ s}$	at / bei $I_{pp}, t_p = 1 \text{ ms}$
		$V_{BRmin} \text{ [V]} \quad V_{BRmax}$	$V_F \text{ [V]} \quad I_F \text{ [A]}$	$V_C \text{ [V]} \quad I_{pp} \text{ [A]}$
BYZ 35A22	BYZ 35K22	20.0 25.0	< 1.2 100	35 80
BYZ 35A26	BYZ 35K26	24.0 30.0	< 1.2 100	40 80
BYZ 35A32	BYZ 35K32	29.0 36.0	< 1.3 80	50 60
BYZ 35A37	BYZ 35K37	34.0 40.0	< 1.3 80	56 60

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last	$T_C = 150/C$	I_{FAV}	35 A
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25/C$	I_{FSM}	270 / 300 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25/C$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+215/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	– 50...+215/C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thC}	< 0.8 K/W

**Silicon Protectifiers
with TVS characteristics
High-temperature diodes**

**Silizium Schutzgleichrichter
mit Begrenzereigenschaften
Hochtemperaturdioden**



Dimensions / Maße in mm

Power dissipation – Verlustleistung 50 W

Breakdown voltage 20...40 V
Abbruch-Spannung

Metal press-fit case with plastic cover
Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk – Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Breakdown voltage Abbruch-Spannung $I_T = 100 \text{ mA}$		Reverse volt. Sperrspannung $I_R = 50 : \text{A}$	Forward voltage Durchlaßspanng. $t_p = 0.3 \text{ s}$		Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei I_{pp} , $t_p = 1 \text{ ms}$	
Anode	Cathode	V_{BRmin}	V_{BRmax}	V_R [V]	V_F [V]	I_F [A]	V_C [V]	I_{pp} [A]
BYZ 50A22	BYZ 50K22	20.0	25.0	16.0	< 1.1	100	35	100
BYZ 50A26	BYZ 50K26	24.0	30.0	20.0	< 1.1	100	40	100
BYZ 50A32	BYZ 50K32	29.0	36.0	26.0	< 1.2	80	50	80
BYZ 50A37	BYZ 50K37	34.0	40.0	30.0	< 1.2	80	56	80

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 150/C$ I_{FAV} 50 A
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave $T_A = 25/C$ I_{FSM} 360 / 400 A
Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen

Rating for fusing – Grenzlasterintegral, $t < 10 \text{ ms}$ $T_A = 25/C$ i^2t 660 A²s

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+215/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+215/C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

Thermal resistance junction to case R_{thC} < 0.6 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse